

B-2 次の記述は、ダイオードについて述べたものである。□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

- (1) シリコン(Si)等の一つの結晶内にP形とN形の半導体の層を作ったとき、この層を接した状態をPN接合といい、この構造をもつダイオードをPN接合ダイオードという。シリコン(Si)を用いた接合ダイオードは□ア方向電流が非常に少なく、整流用の素子として広く用いられている。
- (2) PN接合ダイオードに加える逆方向電圧を大きくしていくと、ある電圧で電流が急激に増加する。これを□イといい、この特性を利用するダイオードを□ウダイオードという。^{降伏現象}
- (3) PN接合ダイオードに加える逆方向電圧を増加させるほど空乏層の幅が広がるので、接合部の静電容量は□エなる。この特性を利用するダイオードを□オダイオードという。^{バラクタ}

- | | | | | |
|-------|--------|---------|-----|---------|
| 1 大きく | 2 トンネル | 3 降伏現象 | 4 逆 | 5 ガン |
| 6 小さく | 7 ツェナー | 8 ホール効果 | 9 順 | 10 バラクタ |

